

Technical Data Sheet

5mm Phototransistor T-1 3/4

PT334-6C

Features

- Fast response time
- High photo sensitivity
- Pb free
- The product itself will remain within RoHS compliant version.

Descriptions

- PT334-6C is a high speed and high sensitive silicon NPN epitaxial planar phototransistor in a standard 5 Φ package. Due to its water clear epoxy the device is sensitive to visible and near infrared radiation.



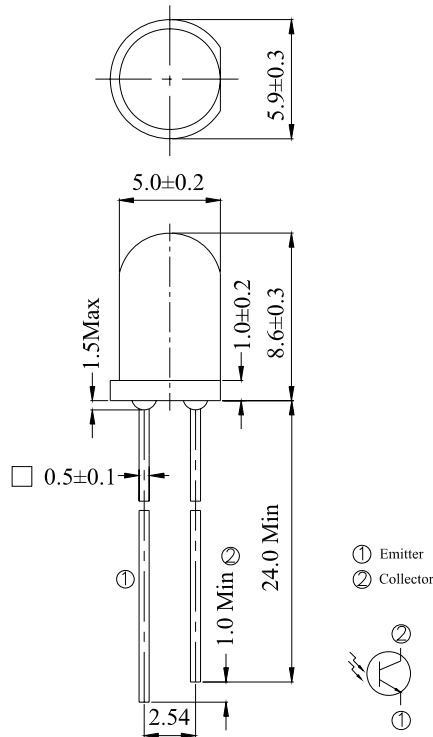
Applications

- Infrared applied system
- Floppy disk drive
- Camera

Device Selection Guide

LED Part No.	Chip	Lens Color
	Material	
PT	Silicon	Water Clear

Package Dimensions



- Notes:** 1.All dimensions are in millimeters
 2.Tolerances unless dimensions $\pm 0.25\text{mm}$

Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Rating	Units
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	30	V
Emitter-Collector-Voltage	V_{ECO}	5	V
Collector Current	I_C	20	mA
Operating Temperature	T_{opr}	-25 ~ +85°C	°C
Storage Temperature	T_{stg}	-40 ~ +85°C	°C
Lead Soldering Temperature	T_{sol}	260	°C
Power Dissipation at (or below) 25°C Free Air Temperature	P_c	75	mW

Notes: *1:Soldering time ≤ 5 seconds.

Electro-Optical Characteristics (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Units
Collector – Emitter Breakdown Voltage	BV_{CEO}	$I_C=100\ \mu A$ $E_e=0mW/cm^2$	30	---	---	V
Emitter-Collector Breakdown Voltage	BV_{ECO}	$I_E=100\ \mu A$ $E_e=0mW/cm^2$	5	---	---	V
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_C=2mA$ $E_e=1mW/cm^2$	---	---	0.4	V
Rise Time	t_r	$V_{CE}=5V$ $I_C=mA$	---	15	---	μS
Fall Time	t_f	$RL=1000\ \Omega$	---	15	---	
Collector Dark Current	I_{CEO}	$E_e=0mW/cm^2$ $V_{CE}=20V$	---	---	100	nA
On State Collector Current	$I_{C(on)}$	$E_e=1mW/cm^2$ $V_{CE}=5V$	1.77	3.5	---	mA
Wavelength of Peak Sensitivity	λ_p	---	---	940	---	nm
Rang of Spectral Bandwidth	$\lambda_{0.5}$	---	---	400-1100	---	nm

Rankings

Parameter	Symbol	Min	Max	Unit	Test Condition
J	$I_{C(ON)}$	1.77	3.61	mA	$V_{CE}=5V$ $E_e=1mW/c\ m^2$
K		2.67	5.07		
L		4.18	7.07		

Typical Electro-Optical Characteristics Curves

Fig.1 Collector Power Dissipation vs. Ambient Temperature

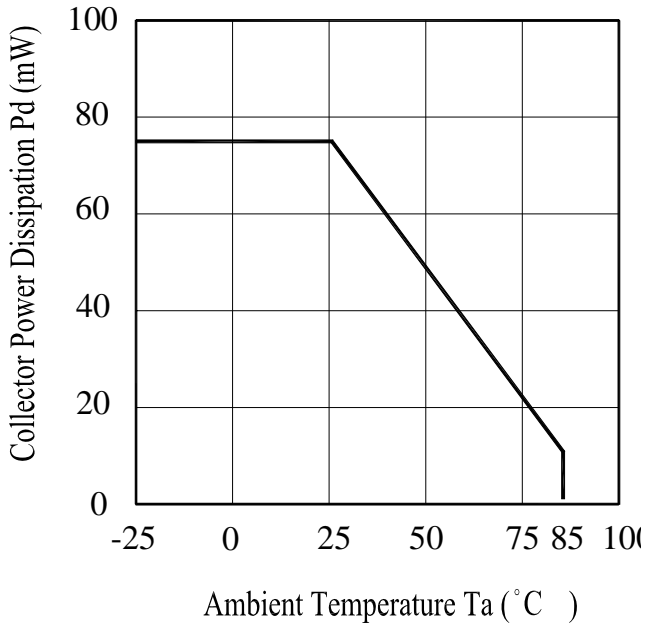


Fig.2 Spectral Sensitivity

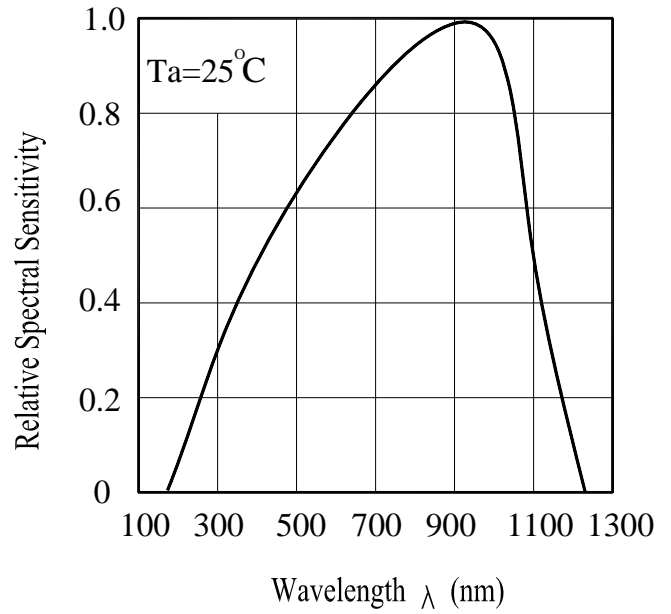


Fig.3 Relative Collector Current vs. Ambient Temperature

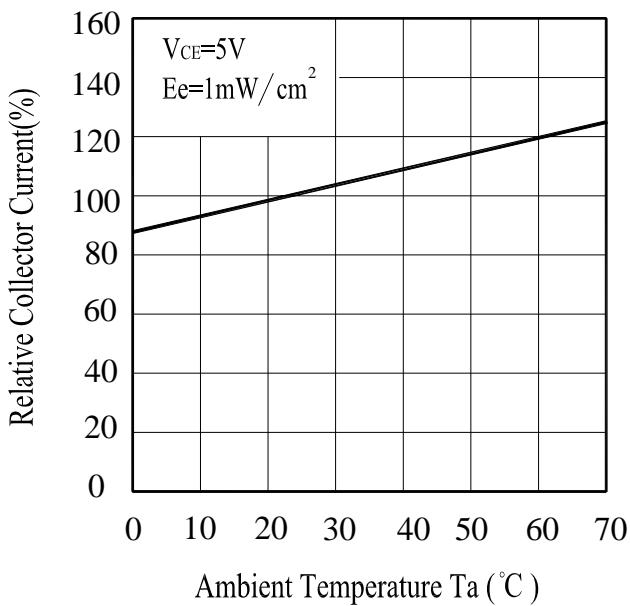
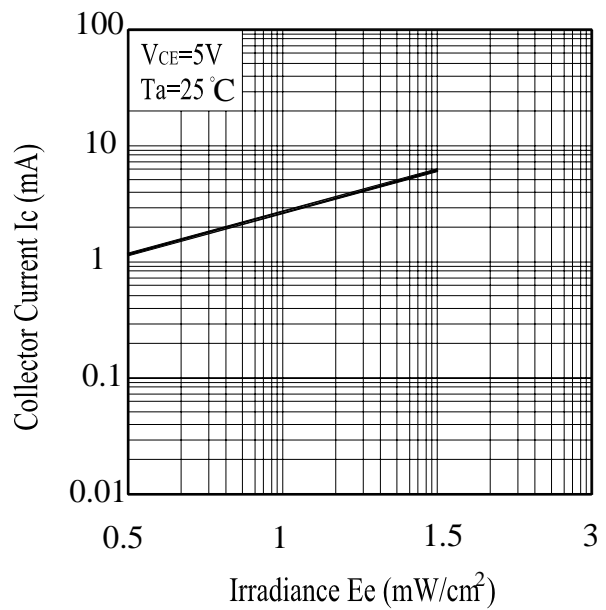


Fig.4 Collector Current vs. Irradiance



Typical Electro-Optical Characteristics Curves

Fig.5 Collector Dark Current vs. Ambient Temperature

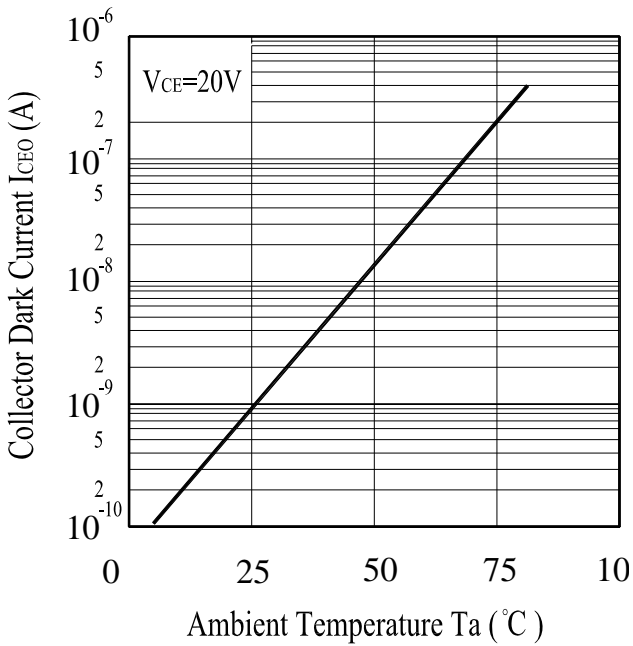
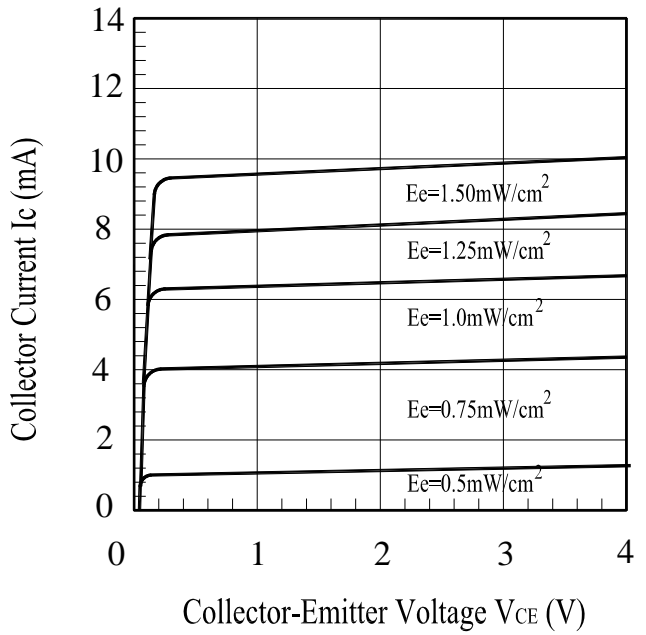


Fig.6 Collector Current vs. Collector-Emitter Voltage



Reliability Test Item And Condition

The reliability of products shall be satisfied with items listed below.

Confidence level : 90%

LTPD : 10%

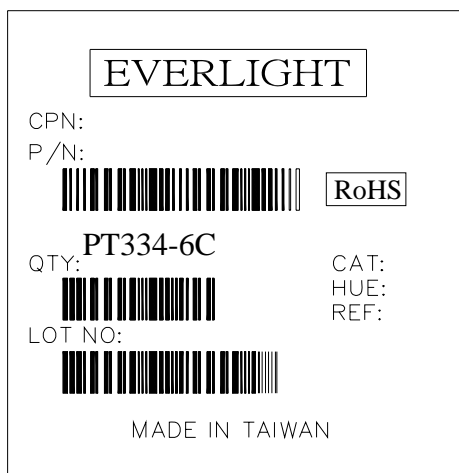
NO.	Item	Test Conditions	Test Hours/ Cycles	Sample Sizes	Failure Judgement Criteria	Ac/Re
1	Solder Heat	TEMP. : 260°C±5°C	10secs	22pcs	$I_{C(ON)} \leq L \times 0.8$ L : Lower Specification Limit	0/1
2	Temperature Cycle	H : +100°C 15mins \updownarrow 5mins L : -40°C 15mins	300Cycles	22pcs		0/1
3	Thermal Shock	H : +100°C 5mins \updownarrow 10secs L : -10°C 5mins	300Cycles	22pcs		0/1
4	High Temperature Storage	TEMP. : +100°C	1000hrs	22pcs		0/1
5	Low Temperature Storage	TEMP. : -40°C	1000hrs	22pcs		0/1
6	DC Operating Life	$V_{CE}=5V$	1000hrs	22pcs		0/1
7	High Temperature/ High Humidity	85°C / 85% R.H	1000hrs	22pcs		0/1

Packing Quantity Specification

1.500PCS/1Bag , 5Bags/1Box

2.10Boxes/1Carton

Label Form Specification



CPN: Customer's Production Number

P/N : Production Number

QTY: Packing Quantity

CAT: Ranks

HUE: Peak Wavelength

REF: Reference

LOT No: Lot Number

MADE IN TAIWAN: Production Place

Notes

1. Above specification may be changed without notice. EVERLIGHT will reserve authority on material change for above specification.
2. When using this product, please observe the absolute maximum ratings and the instructions for using outlined in these specification sheets. EVERLIGHT assumes no responsibility for any damage resulting from use of the product which does not comply with the absolute maximum ratings and the instructions included in these specification sheets.
3. These specification sheets include materials protected under copyright of EVERLIGHT corporation. Please don't reproduce or cause anyone to reproduce them without EVERLIGHT's consent.

EVERLIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

Office: No 25, Lane 76, Sec 3, Chung Yang Rd,
Tucheng, Taipei 236, Taiwan, R.O.C

Tel: 886-2-2267-2000, 2267-9936

Fax: 886-2267-6244, 2267-6189, 2267-6306

<http://www.everlight.com>



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.